

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 3月13日
Date of Application:

出願番号 特願2003-068338
Application Number:

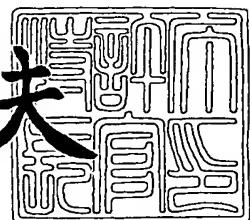
[ST. 10/C] : [JP 2003-068338]

出願人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2003年12月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫





【書類名】 特許願
【整理番号】 J0097033
【提出日】 平成15年 3月13日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G02F 1/13
【発明者】
【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーホームズ株式会社内
【氏名】 土屋 仁
【特許出願人】
【識別番号】 000002369
【氏名又は名称】 セイコーホームズ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100095728
【弁理士】
【氏名又は名称】 上柳 雅裕
【連絡先】 0266-52-3528
【選任した代理人】
【識別番号】 100107076
【弁理士】
【氏名又は名称】 藤岡 英吉
【選任した代理人】
【識別番号】 100107261
【弁理士】
【氏名又は名称】 須澤 修
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 013044
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】**【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 0109826**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置および電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一対の基板間に液晶層を挟持してなり、1つのドット領域内に透過表示を行う透過表示領域と、反射表示を行う反射表示領域とを具備してなる液晶表示装置であって、

前記透過表示領域は、前記1つのドット領域内に複数形成される一方、前記液晶層は、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、前記一対の基板のうちの少なくとも一方の基板と前記液晶層との間に、前記反射表示領域と前記透過表示領域とで前記液晶層の層厚を異ならせる液晶層厚調整層が少なくとも前記反射表示領域に設けられるとともに、

前記1つのドット領域内で隣り合う前記透過表示領域毎に、液晶分子の倒れる方向を各領域の中心から見てそれぞれ逆向きとし、前記反射表示領域において液晶分子の配向する方向を一軸に規制する配向規制手段を具備してなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 前記液晶層厚調整層が、前記反射表示領域と前記透過表示領域との境界付近において傾斜面を備える一方、

前記一対の基板の内面側には前記液晶を駆動するための電極がそれぞれ設けられ、

前記配向規制手段として、前記電極にはスリット状の開口部及び／又は前記電極上に凸部が形成されてなることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】 前記1つのドット領域内で隣り合う前記透過表示領域のうちの第1透過表示領域において、前記液晶層厚調整層が形成された基板側には該液晶層厚調整層の傾斜面上に前記電極の開口部が形成され、また他方の基板側には当該第1透過表示領域の略中央部に位置して前記電極の開口部又は電極上の凸部が形成される一方、

前記1つのドット領域内で隣り合う前記透過表示領域のうちの第2透過表示領域において、前記液晶層厚調整層が形成された基板側には当該第2透過表示領域の略中央部に位置して前記電極の開口部又は電極上の凸部が形成され、また他方

の基板側には前記液晶層厚調整層の傾斜面に対応する部分に位置して前記電極の開口部又は電極上の凸部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置および電子機器に関し、特に反射モードと透過モードの双方で表示を行う半透過反射型の液晶表示装置において、高コントラスト、広視野角の表示が得られる技術に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

反射モードと透過モードとを兼ね備えた半透過反射型液晶表示装置として、上基板と下基板との間に液晶層が挟持されるとともに、例えばアルミニウム等の金属膜に光透過用の開口部を形成した反射膜を下基板の内面に備え、この反射膜を半透過反射板として機能させる液晶表示装置が提案されている。この場合、反射モードでは上基板側から入射した外光が、液晶層を通過した後に下基板の内面の反射膜で反射され、再び液晶層を通過して上基板側から出射され、表示に寄与する。一方、透過モードでは下基板側から入射したバックライトからの光が、反射膜の開口部から液晶層を通過した後、上基板側から外部に出射され、表示に寄与する。したがって、反射膜の形成領域のうち、開口部が形成された領域が透過表示領域、その他の領域が反射表示領域となる。

【0003】

ところが、従来の半透過反射型液晶装置には、透過表示での視角が狭いという課題があった。これは、視差が生じないよう液晶セルの内面に半透過反射板を設けている関係で、観察者側に備えた1枚の偏光板だけで反射表示を行わなければならぬという制約があり、光学設計の自由度が小さいためである。そこで、この課題を解決するために、特許文献1では、垂直配向液晶を用いる新しい半透過

反射型液晶表示装置が提案されている。その特徴は、以下の3点である。（1）誘電異方性が負の液晶を基板に対して垂直に配向させ、電圧印加によってこれを倒す「VA（Vertical Alignment）モード」を採用している点。（2）透過表示領域と反射表示領域の液晶層厚（セルギャップ）が異なる「マルチギャップ構造」を採用している点。（3）透過表示領域を正八角形又は円とし、この領域内で液晶が等方的に倒れるように対向基板上の透過表示領域の中央に突起を設けている点。すなわち、「配向分割構造」を採用している点。

【0004】

【特許文献1】

特開2002-350853号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上述したように、特許文献1の液晶表示装置においては、透過表示領域の中央に突起を設け、液晶の配向方向を制御している。ところで、現在携帯機器等への応用分野においては、より明るく、コントラストの高い表示が求められており、反射表示よりも透過表示を重視する傾向が強まっている。このような事情の下、一つのドット内で透過表示領域の占める面積が大きくなっている。このように透過表示領域の占める面積を大きくした場合、上記特許文献1に開示された構成のように、透過表示領域の中央に突起を設けただけでは配向制御が完全に行われない懼れがあり、ディスクリネーションと呼ばれる配向乱れが生じ、これが残像等の表示不良の原因になる場合がある。また、液晶の各々の配向領域は異なる視角特性を有するため、斜め方向から液晶表示装置を見たときに、ざらざらとしたしみ状のむらが視認されるという不具合も生じ得る。一方、反射表示領域においても液晶分子の倒れる方向を規制する必要があるが、上記特許文献1では透過表示領域の中央の突起により反射表示領域においても配向制御がなされるとしているものの効果的に制御できるものとは言い難い。

【0006】

本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、反射表示及び透過表示の双方において残像等の表示不良が抑えられ、さらには高輝度化、高コントラ

スト化が可能であり、特に透過表示を重視した用途に好適な半透過反射型の液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明の液晶表示装置は、一対の基板間に液晶層を挟持してなり、1つのドット領域内に透過表示を行う透過表示領域と、反射表示を行う反射表示領域とを具備してなる液晶表示装置であって、前記透過表示領域は、前記1つのドット領域内に複数形成される一方、前記液晶層は、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、前記一対の基板のうちの少なくとも一方の基板と前記液晶層との間に、前記反射表示領域と前記透過表示領域とで前記液晶層の層厚を異ならせる液晶層厚調整層が少なくとも前記反射表示領域に設けられるとともに、前記1つのドット領域内で隣り合う前記透過表示領域毎に液晶分子の倒れる方向を逆とし、前記反射表示領域において液晶分子の配向する方向を一軸に規制する配向規制手段を具備してなることを特徴とする。

【0008】

このような液晶表示装置によると、1つのドット領域内に透過表示領域を複数形成したため、1つのドット領域内に同一形状（同一面積）の透過表示領域を1つ形成した場合に比して大きな透過率を得ることができ、透過用途に好適な表示装置となる。

また、本発明の液晶表示装置では、反射表示領域と透過表示領域とで液晶層の層厚を異ならせる液晶層厚調整層を設けたため、反射表示領域と透過表示領域との間のリタデーション差が低減されている。すなわち、反射表示においては表示面側から入射した光が液晶層を2回通過して表示に供されるのに対し、透過表示においては背面側から入射した光が液晶層を1回通過して表示に供されるため、各表示についてリタデーション差が生じることとなるが、本発明では液晶層厚調整層を形成することによってそのリタデーション差を低減し、それに基づくコントラストの低下を解消している。

さらに、本発明の液晶表示装置では、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電率

異方性が負の液晶にて液晶層を構成し、その垂直配向した液晶の倒れる方向について上述のように配向規制手段により規制するものとしたため、配向乱れが生じ難く、該配向乱れに基づく残像等の表示不良が生じ難いものとなっている。すなわち、1つのドット領域内で隣り合う透過表示領域毎に液晶分子の倒れる方向を逆とし、反射表示領域において液晶分子の配向する方向を一軸に規制するものとしたため、透過率を相対的に大きくした場合にも配向分割を完全に行うことができ、反射表示領域及び透過表示領域の双方において配向不良に基づく表示不良の発生を防止することができたのである。なお、本発明においては、各透過表示領域の面積の合計を反射表示領域の面積よりも大きく構成することで、透過表示の用途が高い電子機器の表示部に一層好適なものとなり得る。

【0009】

本発明の液晶表示装置において、液晶層厚調整層が反射表示領域と透過表示領域との境界付近に傾斜面を備える一方、一対の基板の内面側には液晶を駆動するための電極をそれぞれ設けることができ、この場合、上記配向規制手段として、電極にスリット状の開口部を設ける、及び／又は電極上に凸部を形成することで液晶分子の倒れる方向を規制することが可能となる。

【0010】

電極にスリット状の開口部を設けることにより、双方の基板上の電極間に発生する電界（ポテンシャル線）が開口部の近傍で斜めに歪み、この歪んだ斜め電界の作用によって液晶の配向制御を容易に実現することができる。また、電極上に凸部（突起）を設けた場合には、液晶層の中に突出した突起物の作用によって液晶の配向方向を制御することができる。そして、これらを適宜組み合わせることにより、上述したような1つのドット領域内で隣り合う透過表示領域毎に液晶分子の倒れる方向を逆とし、反射表示領域においては液晶分子の配向する方向を一軸に規制することが可能となるのである。

【0011】

ここで、本発明の構成においては、透過表示領域と反射表示領域の境界に液晶層厚調整層の傾斜面が存在しているので、透過表示領域の周囲が液晶層厚調整層の傾斜面で囲まれる形となる。したがって、透過表示領域においては、該領域の

略中央部及び境界部付近に上記開口部及び／又は凸部を形成することが好ましい。
。

【0012】

具体的には、1つのドット領域内で隣り合う透過表示領域のうちの第1透過表示領域において、液晶層厚調整層が形成された基板側であって該液晶層厚調整層の傾斜面上に電極の開口部を形成し、また他方の基板側であって当該第1透過表示領域の略中央部に電極の開口部又は電極上の凸部を形成することが好ましい。この場合、第1透過表示領域の略中央部に形成した開口部又は凸部を中心として傾斜面に向かって液晶分子の倒れる方向が規制されることとなる。なお、傾斜面における配向規制手段としては凸部を形成することが製造上困難であるため開口部に限定される。

そしてこのような第1透過表示領域に対し、1つのドット領域内で隣り合う第2透過表示領域においては、液晶層厚調整層が形成された基板側であって当該第2透過表示領域の略中央部に位置して電極の開口部又は電極上の凸部を形成し、また他方の基板側であって液晶層厚調整層の傾斜面に対応する部分に位置して電極の開口部又は電極上の凸部を形成することができる。この場合、液晶分子の倒れる方向が隣り合う透過表示領域毎に逆となり（各領域の中心から見てそれぞれ倒れる方向が異なる）、また、各透過表示領域の間に形成される反射表示領域においては、傾斜面に形成された開口部と、他方の傾斜面に対応する位置に形成された開口部又は凸部とにより、液晶分子の倒れる方向が一方向に規制されることとなる。したがって、高い透過率を確保しつつ、液晶分子の配向不良に基づく表示不良を抑制することができ、その結果、高輝度、高コントラストの液晶表示装置を提供することが可能となる。

【0013】

なお、本発明において「液晶層厚調整層の傾斜面に対応する部分に位置して電極の開口部又は電極上の凸部を設ける」とは、「平面視したときに液晶層厚調整層の傾斜面と少なくとも一部重なる位置に開口部又は凸部を設ける」という意味である。

【0014】

次に、本発明の電子機器は、上記本発明の液晶表示装置を備えたことを特徴とする。この構成によれば、使用環境によらずに明るく、高コントラスト、広視野角の液晶表示部を備えた電子機器を提供することができ、特に透過表示を重視した電子機器としては好適となる。

【0015】

【発明の実施の形態】

[第1の実施の形態]

以下、本発明の第1の実施の形態を図1～図3を参照して説明する。

本実施の形態の液晶表示装置は、スイッチング素子として薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor, 以下、TFTと略記する）を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置の例である。

【0016】

図1は本実施の形態の液晶表示装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に配置された複数のドットの等価回路図、図2はTFTアレイ基板のドット内の構造を示す平面図、図3は同、液晶表示装置の構造を示す断面図であって、図2のA-A'線に沿う断面図、である。なお、以下の各図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせてある。

【0017】

本実施の形態の液晶表示装置において、図1に示すように、画像表示領域を構成するマトリクス状に配置された複数のドットには、画素電極9と当該画素電極9を制御するためのスイッチング素子であるTFT30がそれぞれ形成されており、画像信号が供給されるデータ線6aが当該TFT30のソースに電気的に接続されている。データ線6aに書き込む画像信号S1、S2、…、Snは、この順に線順次に供給されるか、あるいは相隣接する複数のデータ線6aに対してグループ毎に供給される。また、走査線3aがTFT30のゲートに電気的に接続されており、複数の走査線3aに対して走査信号G1、G2、…、Gmが所定のタイミングでパルス的に線順次で印加される。また、画素電極9はTFT30のドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子であるTFT30を一定

期間だけオンすることにより、データ線6aから供給される画像信号S1、S2、…、Snを所定のタイミングで書き込む。

【0018】

画素電極9を介して液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号S1、S2、…、Snは、後述する共通電極との間で一定期間保持される。液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能にする。ここで、保持された画像信号がリークすることを防止するために、画素電極9と共通電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量70が付加されている。なお、符号3bは容量線である。

【0019】

次に、図2に基づいて、本実施の形態の液晶装置を構成するTFTアレイ基板の平面構造について説明する。

図2に示すように、TFTアレイ基板10上に、複数の矩形状の画素電極9（点線部9Aにより輪郭を示す）がマトリクス状に設けられており、画素電極9の縦横の境界に各々沿ってデータ線6a、走査線3aおよび容量線3bが設けられている。本実施の形態において、各画素電極9および各画素電極9を囲むように配設されたデータ線6a、走査線3a、容量線3b等が形成された領域の内側が1つのドット領域であり、マトリクス状に配置された各ドット領域毎に表示が可能な構造になっている。

【0020】

データ線6aは、TFT30を構成する、例えばポリシリコン膜からなる半導体層1aのうち、後述のソース領域にコンタクトホール5を介して電気的に接続されており、画素電極9は、半導体層1aのうち、後述のドレイン領域にコンタクトホール8を介して電気的に接続されている。また、半導体層1aのうち、チャネル領域（図中左上がりの斜線の領域）に対向するように走査線3aが配置されており、走査線3aはチャネル領域に対向する部分でゲート電極として機能する。

【0021】

容量線3bは、走査線3aに沿って略直線状に延びる本線部（すなわち、平面

的に見て、走査線3aに沿って形成された第1領域)と、データ線6aと交差する箇所からデータ線6aに沿って前段側(図中上向き)に突出した突出部(すなわち、平面的に見て、データ線6aに沿って延設された第2領域)とを有する。そして、図2中、右上がりの斜線で示した領域には、複数の第1遮光膜11aが設けられている。

【0022】

また、1つのドット領域内には、2つの開口部20a, 20aを備える反射膜20が形成されており、この反射膜20が形成された領域が反射表示領域Rとなり、その内側の反射膜20が形成されていない領域(開口部20aの内側領域)が透過表示領域T1, T2となる。また、平面視した際に反射膜20の形成領域を内部に含むように矩形枠状の絶縁膜21(液晶層厚調整層)が形成されている。本実施の形態の場合、絶縁膜21は傾斜面21a(図3参照)を有しており、本明細書では、この部分を反射表示領域Rと透過表示領域T1, T2との境界領域と定義する。

【0023】

次に、図3に基づいて本実施の形態の液晶表示装置の断面構造について説明する。図3は図2のA-A'線に沿う断面図であるが、本発明は絶縁膜や電極の構成等に特徴があり、TFTやその他の配線等の断面構造は従来のものと変わらないため、TFTや配線部分の図示および説明は省略する。

【0024】

図3に示すように、本実施の形態の液晶表示装置は、TFTアレイ基板10とこれに対向配置された対向基板25との間に初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなる液晶層50が挟持されている。TFTアレイ基板10は、石英、ガラス等の透光性材料からなる基板本体10Aの表面にアルミニウム、銀等の反射率の高い金属膜からなる反射膜20が形成されている。上述したように、反射膜20の形成領域が反射表示領域Rとなり、反射膜20の非形成領域が透過表示領域T1, T2となる。

【0025】

反射表示領域R内に位置する反射膜20上、および透過表示領域T1, T2内

に位置する基板本体10A上に、カラーフィルターを構成する色素層22が設けられている。この色素層22は、隣接するドット領域毎に赤(R)、緑(G)、青(B)の異なる色の色素層が配置されており、隣接する3つのドット領域で1つの画素を構成する。あるいは、反射表示と透過表示とで表示色の彩度が異なるのを補償すべく、反射表示領域Rと透過表示領域T1(T2)とで色純度を変えた色素層を別個に設けてもよい。

【0026】

カラーフィルターの色素層22の上には反射表示領域Rに対応する位置に絶縁膜21が形成されている。絶縁膜21は例えば膜厚が $2\text{ }\mu\text{m}\pm1\text{ }\mu\text{m}$ 程度のアクリル樹脂等の有機膜からなり、反射表示領域Rと透過表示領域T1(T2)との境界付近において、自身の層厚が連続的に変化するべく傾斜面21aを有している。ここで、絶縁膜21が存在しない部分の液晶層50の厚みが $2\sim6\text{ }\mu\text{m}$ 程度であるから、反射表示領域Rにおける液晶層50の厚みは透過表示領域T1(T2)における液晶層50の厚みの約半分となる。つまり、絶縁膜21は、自身の膜厚によって反射表示領域Rと透過表示領域T1(T2)との液晶層50の層厚を異ならせる液晶層厚調整層として機能している。本実施の形態の場合、絶縁膜21の上部の平坦面の縁と反射膜20(反射表示領域)の縁とが略一致しており、傾斜面21aは透過表示領域Tに含まれることになる。

【0027】

そして、絶縁膜21の表面を含むTFTアレイ基板10の表面には、インジウム錫酸化物(Indium Tin Oxide, 以下、ITOと略記する)等の透明導電膜からなる画素電極9が形成されている。また、画素電極9上には、ポリイミド等からなる配向膜(図示略)が形成されている。

【0028】

一方、対向基板25側は、ガラスや石英等の透光性材料からなる基板本体25A上に、ITO等の透明導電膜からなる共通電極31、ポリイミド等からなる配向膜(図示略)が順次形成されている。TFTアレイ基板10、対向基板25の双方の配向膜(図示略)には、ともに垂直配向処理が施されているが、ラビングなどのプレチルトを付与する手段は施されていない。

【0029】

また、TFTアレイ基板10の外面側、および対向基板25の外面側には、それぞれ基板本体側から位相差板43、41、偏光板44、42が設けられている。位相差板43、41は可視光の波長に対して略1/4波長の位相差を持つものであり、この位相差板43、41と偏光板44、42との組み合わせによりTFTアレイ基板10側および対向基板25側の双方から液晶層50に略円偏光が入射されるようになっている。また、TFTアレイ基板10の外面側にあたる液晶セルの外側には、光源61、リフレクタ62、導光板63などを有するバックライト64が設置されている。

【0030】

ここで、本実施の形態の液晶表示装置においては、液晶層50の液晶分子を配向規制するために画素電極9及び共通電極31の所定位置にスリットを設けている。具体的には、画素電極9には、透過表示領域T1であって絶縁膜21の傾斜面21aに対応した領域Dにスリットが形成され、また透過表示領域T2の中央部付近Bにおいてもスリットが形成されている。一方、共通電極31には、透過表示領域T1の中央部付近Cにおいてスリットが形成され、また透過表示領域T2であって絶縁膜21の傾斜面21aに対応した領域（傾斜面21aの上方に位置する領域）Aにスリットが形成されている。

【0031】

このような液晶表示装置によれば、反射表示領域Rに絶縁膜21を設けたことによって反射表示領域Rの液晶層50の厚みを透過表示領域Tの液晶層50の厚みの略半分と小さくすることができるので、反射表示に寄与するリタデーションと透過表示に寄与するリタデーションを略等しくすることができ、これによりコントラストの向上を図ることができる。

【0032】

さらに、透過表示領域を1つの画素内に複数形成したため、十分な透過率を得ることが可能となり得る。そして、このように透過表示領域を複数形成した場合において、1つのドット領域内で隣接する透過表示領域T1、T2について、上述のように領域中央部B、C及び傾斜面21aの対応部A、Dに、各領域T1、

T₂それぞれ互い違いの基板側に電極スリットを形成した。したがって、図4に示すように1つのドット内で隣接する透過表示領域T₁，T₂毎に液晶分子50bの倒れる方向が逆となり、さらに反射表示領域においては液晶分子の配向する方向が一方向に規制されることとなる。すなわち、電極に対してスリットを形成したために、上下の電極間に加わる電界が斜めに歪み、斜め電界の作用によって液晶分子の配向方向を制御することができたのである。そして、そのスリットを各領域T₁，T₂毎に、スリットを形成する位置（領域中央部及び傾斜面）と、スリットを形成する電極（画素電極及び共通電極）との関係を互い違いにしたため、各領域T₁，T₂の間に位置する反射表示領域Rにおいて液晶分子の倒れる方向を一方向に定めることができたのである。

【0033】

したがって、本実施の形態の液晶表示装置によると、ディスクリネーションの発生が抑制されるため、ディスクリネーションの発生に伴う残像や斜め方向から観察したときのざらしみ、ムラ等の少ない高品質な表示が得られる。そして、このような作用により、光抜け等の表示不良がなく、高コントラスト、広視野角（160°コーンで1:10以上のコントラスト）の表示を実現することができた。

【0034】

[第2の実施の形態]

以下、本発明の第2の実施の形態を図5を参照して説明する。

図5は本実施の形態の液晶表示装置を示す断面図である。本実施の形態の液晶表示装置の基本構成は第1の実施の形態と全く同様であるため、図5において図3と共に構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。

【0035】

本実施の形態の場合、図5に示すように、透過表示領域T₂の中央部付近Bの画素電極9上に断面が三角形状の突起（凸部）が形成されており、また透過表示領域T₁の中央部付近Cの共通電極31上にも断面が三角形状の突起（凸部）が形成されている。この突起は、例えばアクリル樹脂等の誘電体材料から形成されており、その平面形状は、第1の実施形態のスリットの平面形状と略同様に形成

されている。なお、各電極9, 31及び突起を覆うように配向膜（図示略）が形成されている。一方、透過表示領域T1であって傾斜面21aに対応した領域Dには第1の実施形態と同様に画素電極9にスリットが形成され、また、透過表示領域T2であって傾斜面21aの上方の領域Aには第1の実施形態と同様に共通電極31にスリットが形成されている。

【0036】

本実施の形態の液晶表示装置によれば、領域B, Cにおいて、第1の実施形態のスリットとは異なり、液晶層50中に突出した突起を形成したが、この場合も図6に示すように、この突起の斜面に沿って液晶分子50bが配向制御されることとなる。すなわち、本実施の形態の場合にも、第1の実施形態と同様に液晶分子50bの配向方向が制御され、これにより、光抜け等の表示不良がなく、高コントラスト、広視野角の表示を実現することができる。

【0037】

以上、本発明に係る第1の実施の形態及び第2の実施の形態を示したが、図3に示した領域A, Cにおいては、共通電極31にスリットを形成した場合、或いは突起を形成した場合のいずれであっても、液晶分子50b（図4又は図6参照）を同様の方向に配向規制することが可能である。また、図3に示した領域Bにおいても、画素電極9にスリットを形成した場合、或いは突起を形成した場合のいずれであっても、液晶分子50b（図4又は図6参照）を同様の方向に配向規制することが可能である。なお、図3に示した領域Dには、傾斜面上に突起を形成することが困難であるため、画素電極9にスリットを形成するものとした。

【0038】

このように図3に示した領域A, B, Cにおいて、電極に対してスリット又は突起のいずれを形成しても、上述した光抜け防止、コントラスト向上、広視野角化等の効果を実現することができる。すなわち、図7に示すように、領域A, B, Cに対するスリット又は突起の選択により、本発明に係る実施例1～実施例8の液晶表示装置を実現することができ、いずれの場合も上述した各実施の形態と同様の効果を発現することができた。なお、上述した第1の実施の形態は図7中実施例1に相当するものであり、第2の実施の形態は実施例4に相当するもので

ある。

【0039】

[電子機器]

次に、本発明の上記実施の形態の液晶表示装置を備えた電子機器の具体例について説明する。

図8は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図8において、符号500は携帯電話本体を示し、符号501は上記液晶表示装置を用いた表示部を示している。

図8に示す電子機器は、上記実施の形態の液晶表示装置を用いた表示部を備えているので、使用環境によらずに明るく、コントラストが高く、広視野角の液晶表示部を備えた電子機器を実現することができる。なお、特に透過表示の際には明るく高コントラストの表示を得るために、透過表示を重視した電子機器として提供可能となる。

【0040】

なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば上記実施の形態ではTFTをスイッチング素子としたアクティブマトリクス型液晶表示装置に本発明を適用した例を示したが、薄膜ダイオード（Thin Film Diode, TFD）スイッチング素子としたアクティブマトリクス型液晶表示装置、パッシブマトリクス型液晶表示装置などに本発明を適用することも可能である。その他、各種構成要素の材料、寸法、形状等に関する具体的な記載は、適宜変更が可能である。

【0041】

また、上記実施形態では、位相差板41、42を単板で構成したが、この代わりに、1/2波長板と1/4波長板との積層体として構成してもよい。この積層体は広帯域円偏光板として機能し、黒表示をより無彩色化にすることができる。さらに、この積層体に負のCプレートを積層させることで更に広視野角化を図ることもできる。なお、Cプレートとは、膜厚方向に光軸を有する位相差板である。

【0042】

さらに、上記実施形態では、液晶層厚調整層として絶縁膜21をTFTアレイ基板10側の基板本体（下基板）10A上に形成したが、対向基板25側の基板本体（上基板）25A上に形成することも可能である。また、カラーフィルタ（着色層22）についても、上記実施形態ではTFTアレイ基板10側の基板本体（下基板）10A上に形成したが、対向基板25側の基板本体（上基板）25A上に形成することも可能である。

【図面の簡単な説明】

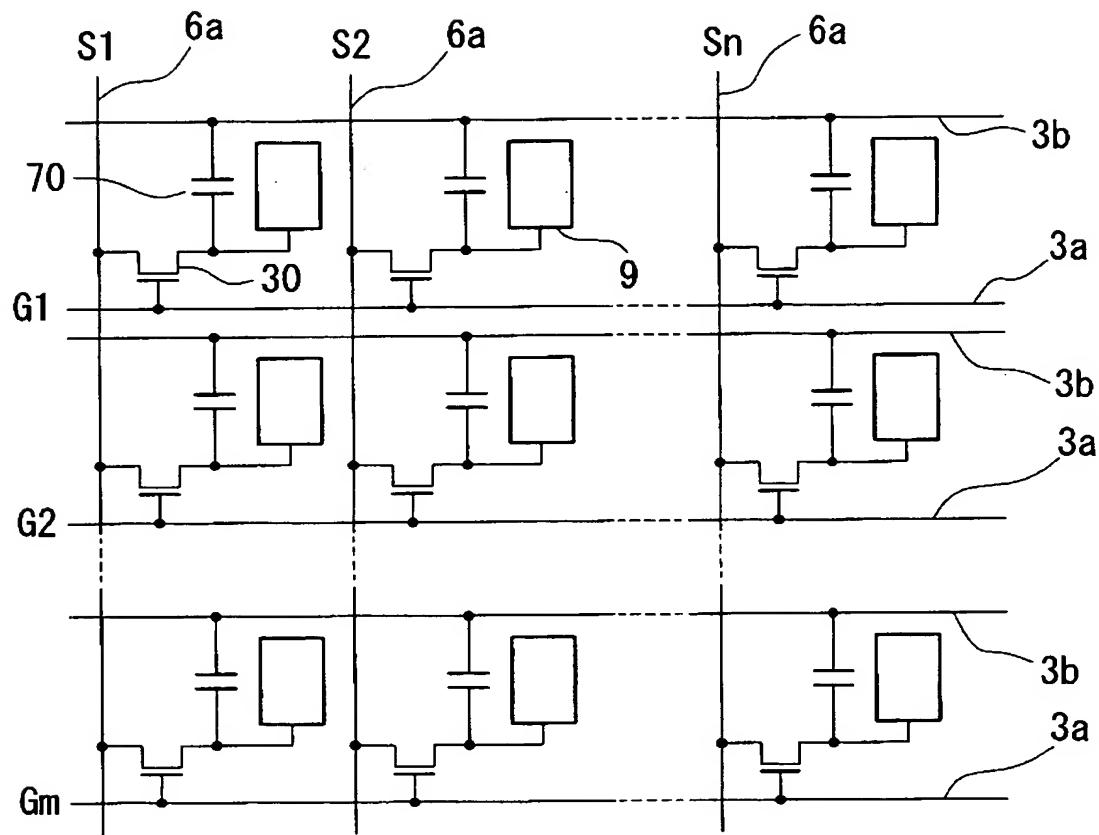
- 【図1】 第1実施形態の液晶表示装置の等価回路図。
- 【図2】 同、液晶表示装置のドットの構造を示す平面図。
- 【図3】 同、液晶表示装置の要部を示す断面模式図。
- 【図4】 第1実施形態の液晶表示装置の作用を示す説明図。
- 【図5】 第2実施形態の液晶表示装置について要部を示す断面模式図。
- 【図6】 第2実施形態の液晶表示装置の作用を示す説明図。
- 【図7】 本発明に係る幾つかの実施例を示す説明図。
- 【図8】 本発明の電子機器の一例を示す斜視図。

【符号の説明】

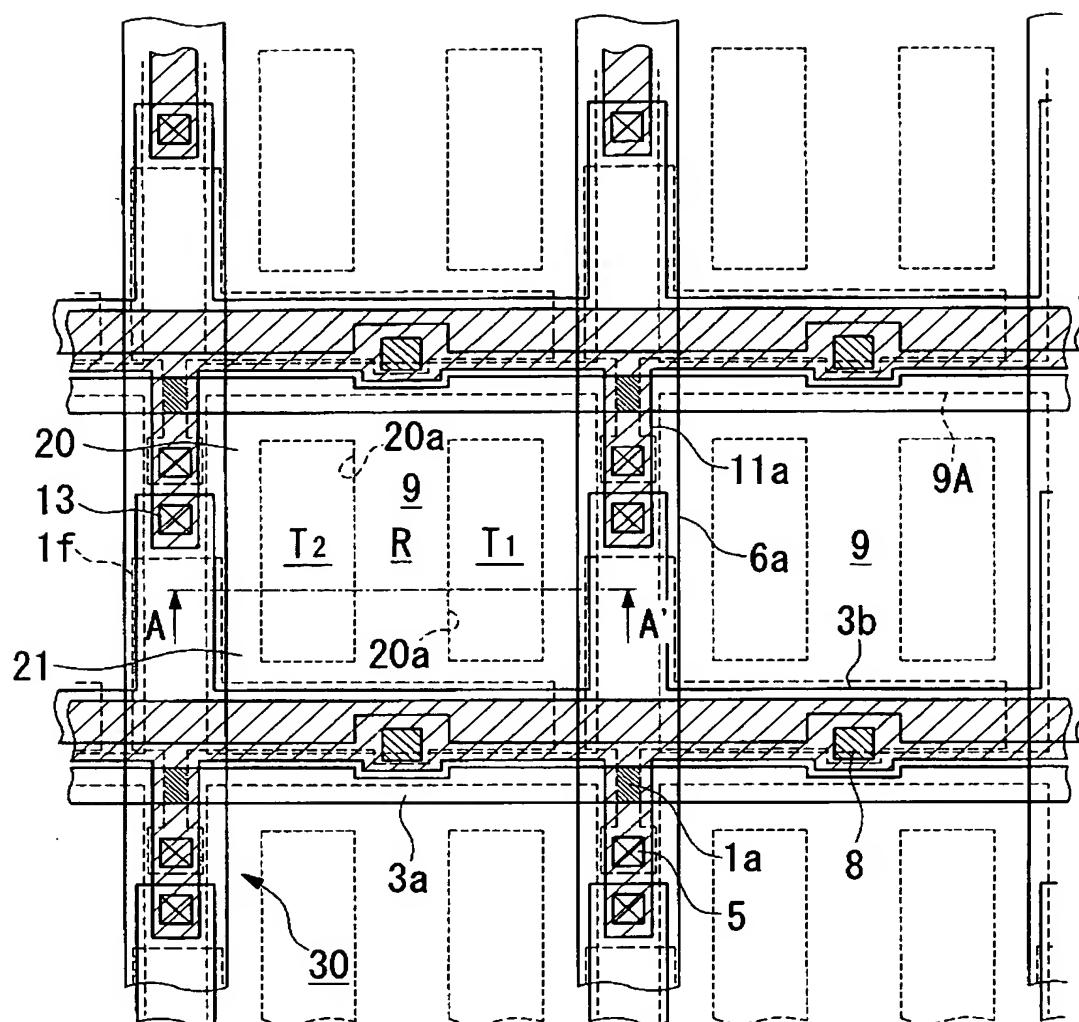
9…画素電極、10…TFTアレイ基板、20…反射膜、21…絶縁膜（液晶層厚調整層）、25…対向基板、50…液晶層、R…反射表示領域、T1, T2…透過表示領域

【書類名】 図面

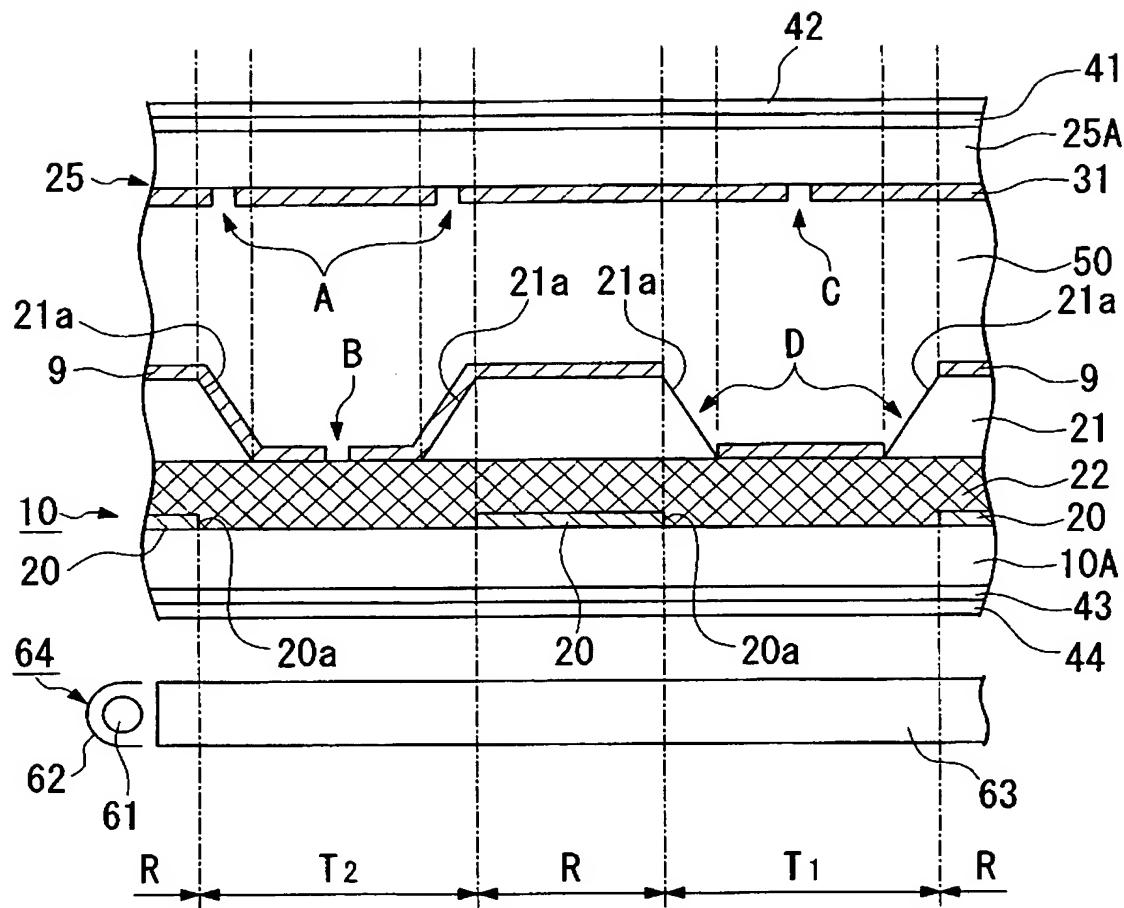
【図1】



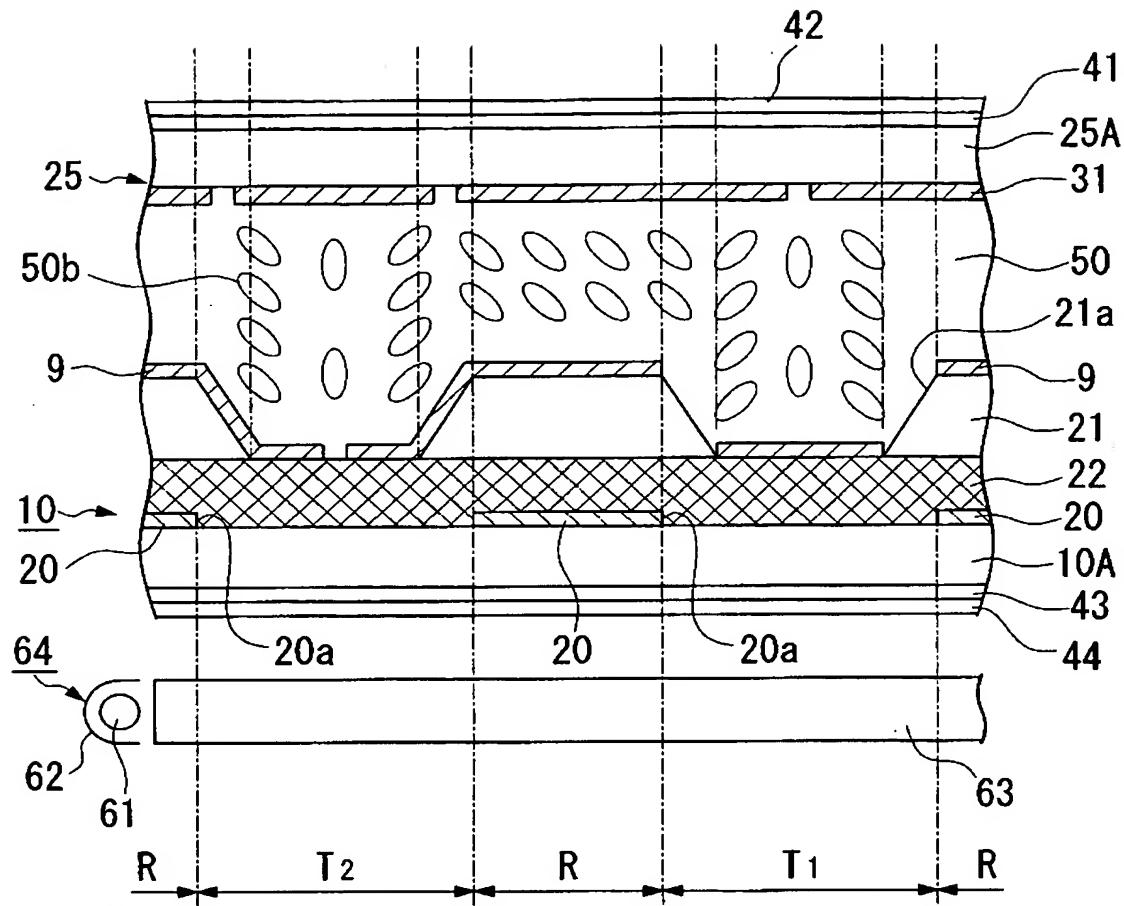
【図2】



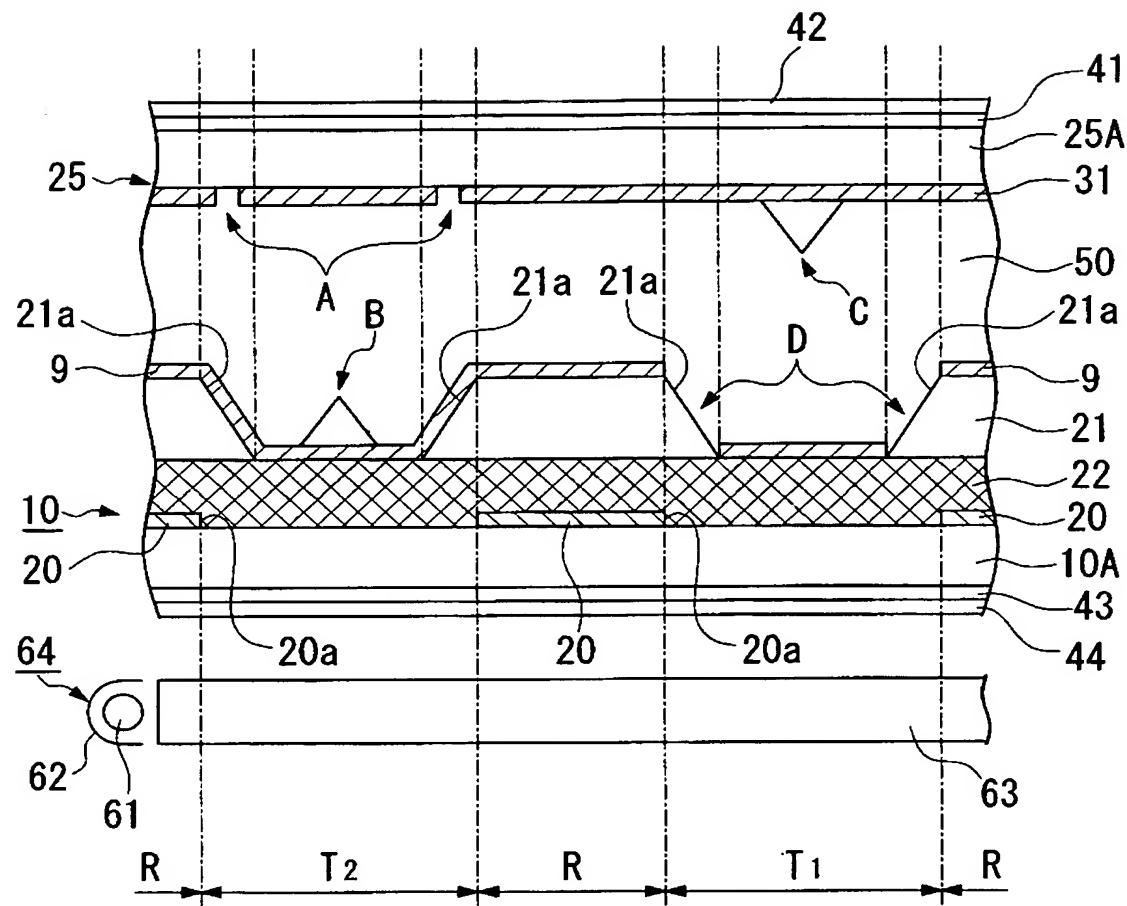
【図3】



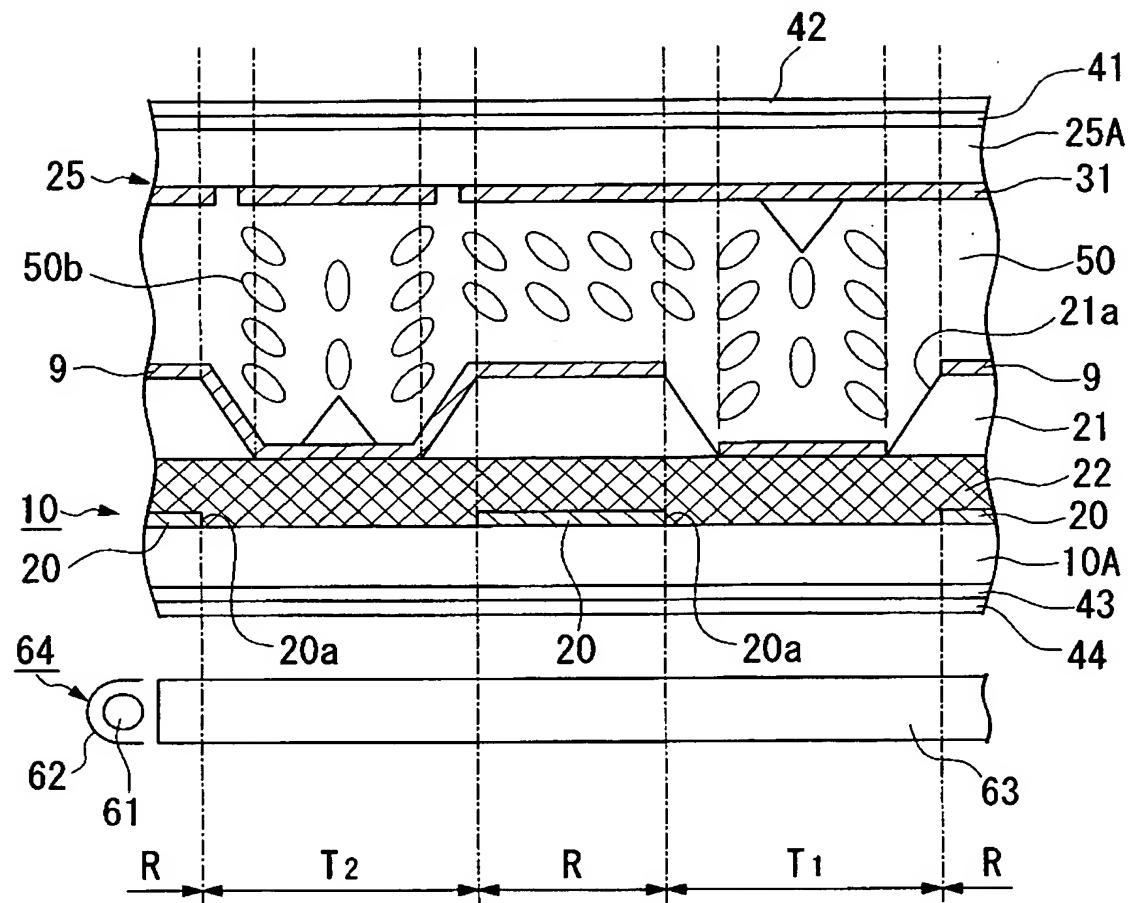
【図4】



【図5】



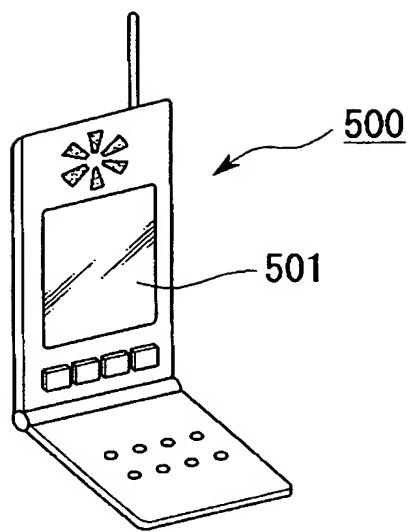
【図6】



【図7】

	A	B	C
実施例1	スリット	スリット	スリット
実施例2	スリット	突起	スリット
実施例3	スリット	スリット	突起
実施例4	スリット	突起	突起
実施例5	突起	スリット	スリット
実施例6	突起	突起	スリット
実施例7	突起	スリット	突起
実施例8	突起	突起	突起

【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 反射表示及び透過表示の双方において残像等の表示不良が抑えられ、さらには高輝度化、高コントラスト化が可能な半透過反射型の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 本発明の液晶表示装置は、一対の基板10A, 25A間に液晶層50を挟持してなり、1つのドット領域内に複数の透過表示領域T1, T2と、反射表示領域Rとを具備してなる液晶表示装置であつて、液晶層50は初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、基板10Aと液晶層50との間に、反射表示領域Rと透過表示領域T1 (T2) とで液晶層50の層厚を異ならせる液晶層厚調整層21が反射表示領域Rに対応して設けられるとともに、各透過表示領域T1, T2毎に液晶分子の倒れる方向を逆とし、反射表示領域Rにおいて液晶分子の配向する方向を一軸に規制する構成とした。

【選択図】 図3

特願2003-068338

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏名 セイコーエプソン株式会社